

平成25年5月8日

## 半導体工学・演習の宿題

松浦

宿題1 III族のガリウム(Ga)とV族のヒ素(As)とで形成される半導体 GaAs では、Ga に 4 個の As が結合し、As に 4 個の Ga が結合し、それぞれの原子の周りには 8 個の電子が存在し、安定している。これは、ちょうど Si が 4 個の Si と結合し、Si の周りには 8 個の電子が存在するのと同じである。

1 - 1 GaAs 半導体を n 型にする方法を述べよ。

1 - 2 GaAs 半導体を p 型にする方法を述べよ。

次回(5月15日)に、A4のレポート用紙で提出すること。